

2SD568, 569

NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波電力増幅および低速度スイッチング用
工業用

NPN Silicon Epitaxial Transistor
Low Frequency Power Amplifier
Low Speed Switching
Industrial Use

特長/FEATURES

- 小形外形に比し、電流量が大きい。 $I_{C(DC)} = 7\text{ A}$
- コレクタ飽和電圧が低い。 $V_{CE(sat)} : 0.5\text{ V MAX.}(I_C = 5\text{ A})$
- ランプドライバ、インダクタンスドライバの用途に最適である。
- コンプリメンタリトランジスタ 2SB707, 708

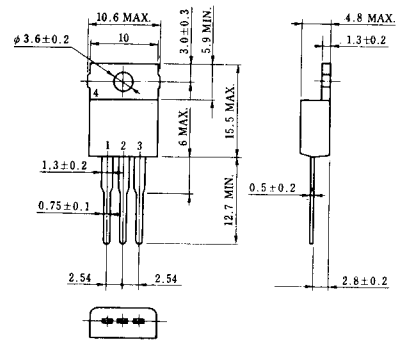
絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	略号	2SD568/2SD569	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	60/80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	7.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	7.0	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	15	A
ベース電流(直流)	$I_{B(DC)}$	3.5	A
全損失	$P_{T(T_c=25^\circ\text{C})}$	40	W
全損失	$P_{T(T_a=25^\circ\text{C})}$	1.5	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

*PW \leq 300 μs , duty cycle \leq 10 %

外形図/PACKAGE DIMENSIONS

(Unit : mm)



電極接続

1. Base
2. Collector
3. Emitter
4. Fin (Collector)

EIAJ : SC-46

JEDEC : TO-220AB

IEC : —

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 80\text{ V}, I_E = 0$			10	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5.0\text{ V}, I_C = 0$			10	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = 1.0\text{ V}, I_C = 3\text{ A}$ *	40		200	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = 1.0\text{ V}, I_C = 5\text{ A}$ *	20			
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 5\text{ A}, I_B = 0.5\text{ A}$ *			0.5	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 5\text{ A}, I_B = 0.5\text{ A}$ *			1.5	V

*パルス測定 PW \leq 350 μs , duty cycle \leq 2 % / Pulsed

h_{FE} 区分(h_{FE1}) / M : 40~80 L : 60~120 K : 100~200